

ポータブル機器用 CMOS LDO レギュレータシリーズ 高効率 DC / DC コンバータ内蔵 システムレギュレータ



BH6172GU

No.11020JAT08

●概要

BH6172GU は DCDCx1ch、LDO レギュレータx5ch をそれぞれ内蔵した LSI です。2.6mmx2.6mm の小型パッケージを採用し、16 段階出力電圧切替、0.8V~の低電圧出力に対応することで、現存するほぼすべてのマルチメディアチップセット、カメラモジュール等に対応可能です。

●特長

- 1) 1ch 500mA、高効率ステップダウンコンバータ(I²C による 16 段階出力可変)
- 2) 5ch CMOS タイプ LDO(I²C による 16 段階出力可変、150mA×3、300mA×2)
- 3) 外部イネーブルピンまたは I²C による ON/OFF 制御
- 4) I²C 互換 I/F(デバイスアドレス“1001111”)
- 5) 小型、2.6mmx2.6mm のウェハーレベル CSP パッケージ
- 6) 放電抵抗切替機能
- 7) LDO レギュレータ部過電流保護機能
- 8) スイッチングレギュレータ部過電流保護機能
- 9) スイッチングレギュレータ部出力過電圧保護機能
- 10) 温度保護機能

●用途

携帯電話、携帯ゲーム機、携帯音楽再生プレイヤー、ポータブル DVD プレイヤー、携帯テレビ、ポータブルナビゲーション、PDA、電子辞書など。

●絶対最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	定格	単位
最大電源電圧(VBAT)	VBATMAX	6.0	V
最大電源電圧(PBAT)	VPBATMAX	6.0	V
最大電源電圧(VUSB)	VUSBMAX	6.0	V
最大電源電圧(DVDD)	DVDDMAX	4.5	V
最大印加電圧 1 (LX、FB、OUT1、OUT2、OUT3、OUT4、OUT5、 EN_LD1、EN_LD2、EN_LD3、EN_LD4)	VINMAX1	VBAT + 0.3	V
最大印加電圧 2 (NRST、CLK、DATA)	VINMAX2	DVDD + 0.3	V
許容損失	Pd	900 ^{*1}	mW
動作温度範囲	Topr	-35 ~ +85	°C
保存温度範囲	Tstg	-55 ~ +125	°C

* 60mmx60mmx1.6mm ガラスエポキシ基板実装時。
Ta=25°C以上で使用する場合は 1°Cにつき、9.0mW を減じる。
*1 Pd 及び ASO を越えないこと。

●動作条件(Ta=25°C)

項目	記号	定格	単位
VBAT 電源電圧	VBAT	2.20 ~ 5.50 ^{*2}	V
PBAT 電源電圧	VPBAT	2.20 ~ 5.50 ^{*2}	V
VUSB 電源電圧	VUSB	2.20 ~ 5.50 ^{*2*3}	V
DVDD 電源電圧	VDVDD	1.70 ~ 4.20 ^{*4}	V

*2 VBAT, PBAT, VUSB と LDO または SWREG の設定電圧の関係によっては、本仕様に記載されたスペックを満足できない場合があります。

*3 VUSB 電源は必要に応じて VBAT, PBAT とショートして使用することが可能です。

*4 DVDD < VBAT, PBAT の条件で使用してください。

●電気的特性 (特に指定のない限り、Ta=25°C、VBAT=PBAT=3.6V、VUSB=5.0V)

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
回路電流						
VBAT 回路電流 1 (OFF)	IQVB1	-	0.4	1	μA	LDO1~5=OFF、SWREG1=OFF NRST=L、DVDD=0V
VUSB 回路電流 1 (OFF)	IQUSB1	-	0	1	μA	
VBAT 回路電流 2 (OFF)	IQVB2	-	0.4	1	μA	LDO1~5=OFF、SWREG1=OFF NRST=L、DVDD=0V VUSB=VBAT 外部接続
VBAT 回路電流 3 (スタンバイ)	IQVB3	-	0.7	1.4	μA	LDO1~5=OFF、SWREG1=OFF NRST=H、DVDD=2.6V
VUSB 回路電流 2 (スタンバイ)	IQUSB2	-	0	1	μA	
VBAT 回路電流 4 (スタンバイ)	IQVB4	-	0.7	1.4	μA	LDO1~5=OFF、SWREG1=OFF NRST=H、DVDD=2.6V VUSB=VBAT 外部接続
VBAT 回路電流 5 (アクティブ)	IQVB5	-	170	300	μA	LDO1~5=ON(no load、初期電圧) SWREG1=ON(no load、初期電圧) NRST=H、DVDD=2.6V
VUSB 回路電流 3 (アクティブ)	IQUSB3	-	35	70	μA	
VBAT 回路電流 6 (アクティブ)	IQVB6	-	200	350	μA	LDO1~5=ON(no load、初期電圧) SWREG1=ON(no load、初期電圧) NRST=H、DVDD=2.6V VUSB=VBAT 外部接続

◎本製品は耐放射線設計はしていません。

●電気的特性 (特に指定のない限り、 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{\text{BAT}}=V_{\text{PBAT}}=3.6\text{V}$ 、 $V_{\text{USB}}=5.0\text{V}$)

項目	記号	規格値			単位	条件	
		最小	標準	最大			
デジタル I/O 電気的特性							
NRST (CMOS 入力)	入力'H'レベル	V _{IH1}	DVDD ×0.7	-	DVDD +0.3	V	端子電圧 : DVDD
	入力'L'レベル	V _{IL1}	-0.3	-	DVDD ×0.3	V	端子電圧 : 0V
	入力リーク電流	I _{IC1}	0	0.3	1	μA	
EN_LD1, EN_LD2, EN_LD3, EN_LD4 (NMOS 入力)	入力'H'レベル	V _{IH2}	1.44	-	-	V	
	入力'L'レベル	V _{IL2}	-	-	0.4	V	
	入力リーク電流	I _{IC2}	-1	0	1	μA	
デジタル I/O 電気的特性 (デジタル端子 : CLK、DATA)							
入力'H'レベル	V _{IH3}	DVDD ×0.8	-	DVDD +0.3	V		
入力'L'レベル	V _{IL3}	-0.3	-	DVDD ×0.2	V		
入力リーク電流	I _{IC3}	-1	0	1	μA	端子電圧 : DVDD	
DATA 出力'L'電圧レベル	V _{OL}	-	-	0.4	V	I _{OL} =6mA	
SWREG							
出力電圧	V _{OSW}	0.94	1.00	1.06	V	初期値 I _o =100mA	
出力電流	I _{O_{SW}}	-	-	500	mA	V _o =1.00V	
効率	η_{SW}	-	90	-	%	I _o =100mA、V _o =2.40V、 V _{BAT} =3.2V	
発振周波数	f _{OSC}	-	1.7	-	MHz	V _o =1.00V	
出力インダクタンス	L _{SWREG}	1.5	2.2	-	μH	T _a = -30~75°C	
短絡電流	I _{SHTSW}	-	500	-	mA	V _o =0V	
出力容量	C _{SWREG}	3.3	4.7	-	μF	T _a = -30~75°C、 SWREG DC バイアス時	

●電気的特性 (特に指定のない限り、Ta=25°C、VBAT=PBAT=3.6V、VUSB=5.0V)

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
LDO1						
出力電圧	VOM1	0.970	1.000	1.030	V	初期値 Io=1mA@VBAT=4.5V Io=150mA@VBAT=3.4V
出力電流	VOM1C	-	-	150	mA	Vo=1.0V
入出力電圧差	VOM1DP	-	0.1	-	V	Io=50mA
入力安定度	Δ VIM1	-	2	-	mV	VBAT=3.4~4.5V、Io=50mA Vo=1.0V
負荷安定度	Δ VLM1	-	20	-	mV	Io=50 μ A~150mA、VBAT=3.6V Vo=1.0V
リップル除去率	RRM1	-	60	-	dB	VR=-20dBV、fR=120Hz Io=50mA、Vo=2.6V BW=20Hz~20kHz
短絡電流	ISHTM3	-	180	-	mA	Vo=0V
出力容量	CoUT1	-	1.0	-	μ F	Ta= -30~75°C LDO DC バイアス時
LDO2						
出力電圧	VOM2	2.522	2.600	2.678	V	初期値 Io=1mA@VBAT=4.5V Io=150mA@VBAT=3.4V
出力電流	VOM2C	-	-	150	mA	Vo=2.6V
入出力電圧差	VOM2DP	-	0.1	-	V	Io=50mA
入力安定度	Δ VIM2	-	2	-	mV	VBAT=3.4~4.5V、Io=50mA Vo=2.6V
負荷安定度	Δ VLM2	-	20	-	mV	Io=50 μ A~150mA、VBAT=3.6V Vo=2.6V
リップル除去率	RRM2	-	60	-	dB	VR=-20dBV、fR=120Hz Io=50mA、Vo=2.6V BW=20Hz~20kHz
短絡電流	ISHTM3	-	180	-	mA	Vo=0V
出力容量	CoUT2	-	1.0	-	μ F	Ta= -30~75°C LDO DC バイアス時
LDO3						
出力電圧	VOM3	2.716	2.800	2.884	V	初期値 Io=1mA@VBAT=4.5V Io=150mA@VBAT=3.4V
出力電流	VOM3C	-	-	300	mA	Vo=2.8V
入出力電圧差	VOM3DP	-	0.1	-	V	Io=50mA
入力安定度	Δ VIM3	-	2	-	mV	VBAT=3.4~4.5V、Io=50mA Vo=2.8V
負荷安定度	Δ VLM3	-	20	-	mV	Io=50 μ A~300mA、VBAT=3.6V Vo=2.8V
リップル除去率	RRM3	-	60	-	dB	VR=-20dBV、fR=120Hz Io=50mA、Vo=2.6V BW=20Hz~20kHz
短絡電流	ISHTM3	-	180	-	mA	Vo=0V
出力容量	CoUT3	-	1.0	-	μ F	Ta= -30~75°C LDO DC バイアス時

●電気的特性 (特に指定のない限り、Ta=25°C、VBAT=PBAT=3.6V、VUSB=5.0V)

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
LDO4						
出力電圧	VOM4	1.746	1.800	1.854	V	初期値 Io=1mA@VBAT=4.5V Io=300mA@VBAT=3.4V
出力電流	VOM4C	-	-	300	mA	Vo=1.8V
入出力電圧差	VOM4DP	-	0.1	-	V	Io=50mA
入力安定度	Δ VIM4	-	2	-	mV	VBAT=3.4~4.5V、Io=50mA Vo=1.8V
負荷安定度	Δ VLM4	-	30	-	mV	Io=50 μ A~300mA、VBAT=3.6V Vo=1.8V
リップル除去率	RRM4	-	60	-	dB	VR=-20dBV、fR=120Hz Io=50mA、Vo=2.6V BW=20Hz~20kHz
短絡電流	ISHTM4	-	340	-	mA	Vo=0V
出力容量	COUT4	-	1.0	-	μ F	Ta= -30~75°C LDO DC バイアス時
LDO5						
出力電圧	VOM5	3.201	3.300	3.399	V	初期値 Io=1mA@VUSB=5.5V Io=150mA@VUSB=4.4V
出力電流	VOM5C	-	-	150	mA	Vo=3.3V
入出力電圧差	VOM5DP	-	0.1	-	V	Io=50mA
入力安定度	Δ VIM5	-	2	-	mV	VUSB=4.4~5.5V、Io=50mA Vo=3.3V
負荷安定度	Δ VLM5	-	20	-	mV	Io=50 μ A~150mA、VUSB=5.5V Vo=3.3V
リップル除去率	RRM5	-	60	-	dB	VR=-20dBV、fR=120Hz Io=50mA、Vo=2.6V BW=20Hz~20kHz
短絡電流	ISHTM5	-	180	-	mA	Vo=0V
出力容量	COUT5	-	1.0	-	μ F	Ta= -30~75°C LDO DC バイアス時

●SWREG & LDO 出力電圧一覧

項目	用途例	電源	初期値	最大負荷	可変範囲
SWREG	CORE	VBAT/PBAT	1.00V	500mA	0.80-2.40V
LDO1	CORE	VBAT	1.00V	150mA	1.00-3.30V
LDO2	I/O1	VBAT	2.60V	150mA	1.00-3.30V
LDO3	MEMORY	VBAT	2.80V	300mA	1.20-3.30V
LDO4	I/O2	VBAT	1.80V	300mA	1.20-3.30V
LDO5	USB	VBAT/VUSB	3.30V	150mA	1.20-3.30V

項目	SWREG	LDO1	LDO2	LDO3	LDO4	LDO5
出力電圧切換	0.80V	1.00V	1.00V	1.20V	1.20V	1.20V
	0.85V	1.10V	1.10V	1.30V	1.30V	1.30V
	0.90V	1.20V	1.20V	1.40V	1.40V	1.40V
	0.95V	1.30V	1.30V	1.50V	1.50V	1.50V
	1.00V	1.40V	1.40V	1.60V	1.60V	1.60V
	1.05V	1.50V	1.50V	1.70V	1.70V	1.70V
	1.10V	1.60V	1.60V	1.80V	1.80V	1.80V
	1.15V	1.70V	1.70V	1.85V	1.85V	1.85V
	1.20V	1.80V	1.80V	1.90V	1.90V	1.90V
	1.365V	1.85V	1.85V	2.00V	2.00V	2.00V
	1.40V	2.60V	2.60V	2.60V	2.60V	2.60V
	1.50V	2.70V	2.70V	2.70V	2.70V	2.70V
	1.65V	2.80V	2.80V	2.80V	2.80V	2.80V
	1.80V	2.85V	2.85V	2.85V	2.85V	2.85V
	1.85V	3.00V	3.00V	3.00V	3.00V	3.00V
2.40V	3.30V	3.30V	3.30V	3.30V	3.30V	

●ブロック図、ボール配置

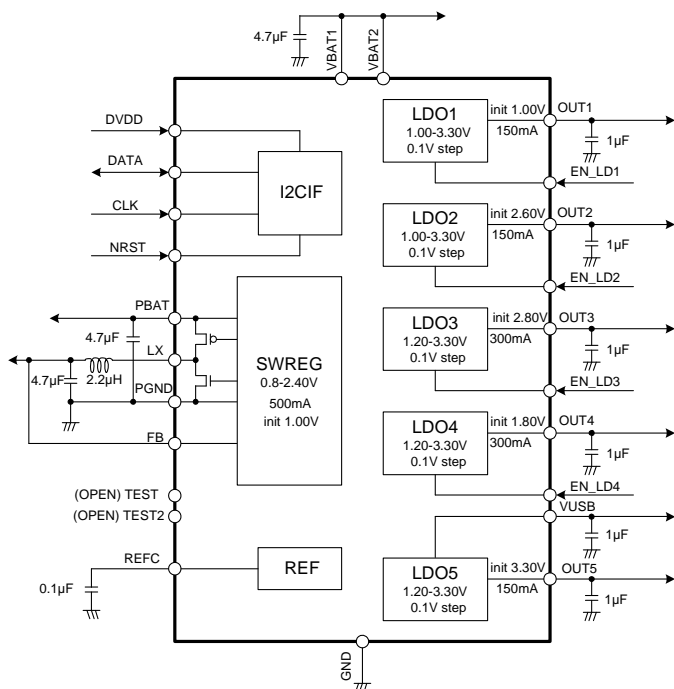


Fig.1 ブロック図

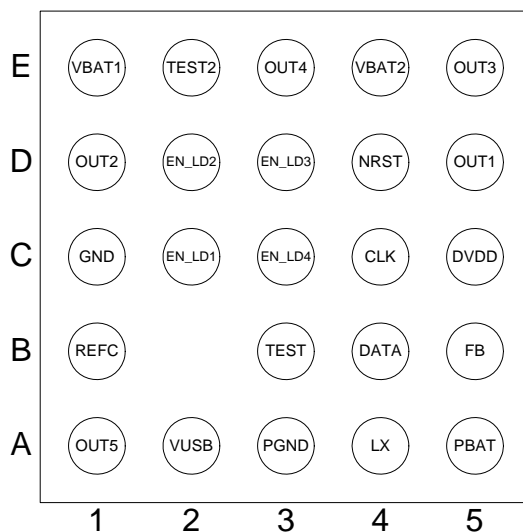


Fig.2 ボール配置

●端子機能

Ball No.	PIN 名	機能
B4	DATA	I2C I/F DATA 入出力
C4	CLK	I2C I/F CLK 入力
E1	VBAT1	VBAT 電源 1
E4	VBAT2	VBAT 電源 2
A5	PBAT	SWREG 部電源
A4	LX	SWREG 用インダクタ接続端子
A3	PGND	SWREG 部 GND
B5	FB	SWREG 用フィードバック端子
D4	NRST	リセット入力(L'アクティブ)
D5	OUT1	LDO1 出力
D1	OUT2	LDO2 出力
E5	OUT3	LDO3 出力
E3	OUT4	LDO4 出力
A1	OUT5	LDO5 出力
B1	REFC	基準電源出力
C2	EN_LD1	LDO1 イネーブル入力
D2	EN_LD2	LDO2 イネーブル入力
D3	EN_LD3	LDO3 イネーブル入力
C3	EN_LD4	LDO4 イネーブル入力
A2	VUSB	USBVBUS 電源 ^{*1}
C5	DVDD	デジタル部電源
C1	GND	アナログ部 GND
B3	TEST	TEST ピン (通常動作時は常時 OPEN)
E2	TEST2	TEST ピン (通常動作時は常時 OPEN)

* TEST、TEST2 ピンは工場出荷工程にて使用します。通常使用時は常時オープンにて使用してください。

*1 必要に応じて VUSB と VBAT を外部ショートで使用することが可能です。

●I²C バスインターフェース

I²C 互換同期式シリアル I/F とは、2 線式のバス上に接続された LSI 間の通信を可能とするもので、本 LSI のレジスタ書き込みによる制御を可能とします。2 線の信号の内、DATA はシリアルデータ信号、CLK はシリアルクロック信号にそれぞれ該当し、アイドル状態である、ないに問わず DVDD 電源へプルアップする必要があります。

1. スタート、ストップ条件

CLK 信号='H'の時、DATA 信号を'H'→'L'とすることでスタート条件を、'L'→'H'とすることでストップ条件を発生します。すべてのコマンドはスタート条件で開始し、ストップ条件にて終了させる必要があります。リードアクセス中にストップ条件が成立した場合には、即座に動作を停止させ、スタンバイへと遷移します。ライトアクセス中にストップ条件が成立した場合には、データの取り込みを中止し、直前の書き込みは無効となり、スタンバイへと遷移します。スタート条件を 2 回以上連続して入力することはできません。

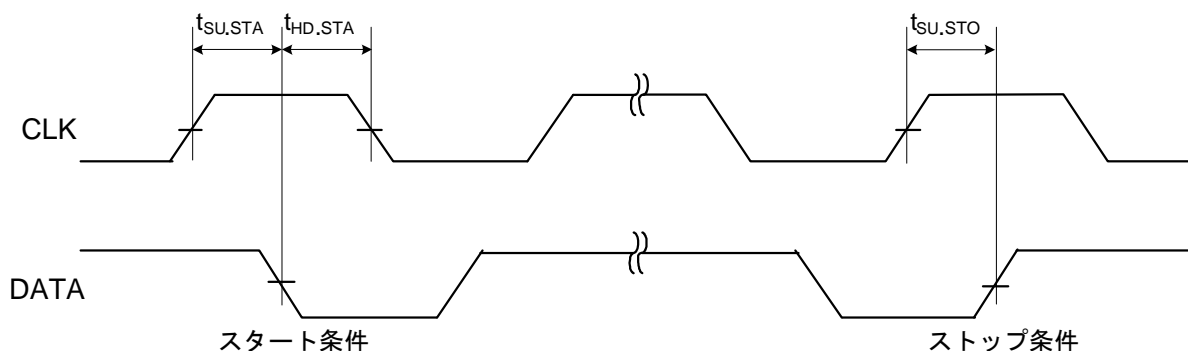


Fig.3 I²C スタート、ストップ条件

2. データ通信

DATA 端子から入力できるデータは CLK='L'の期間中に変更することができる。CLK='H'の時はスタートまたはストップ条件としてデコードされる。

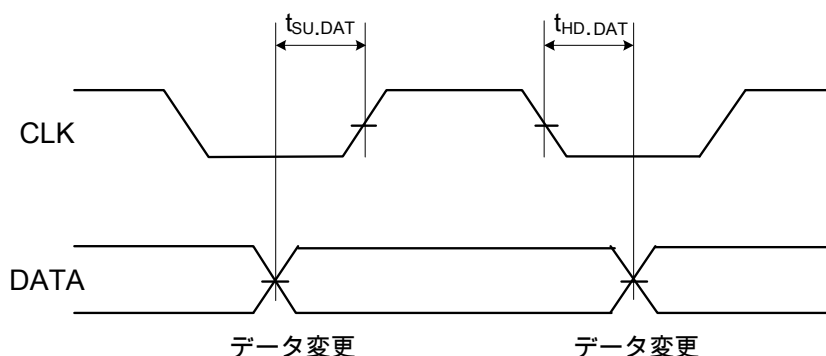


Fig.4 I²C データ変更タイミング

その他のアクノリッジ、ライト、リード動作についてもすべて I²C 規格に準拠する。

3. デバイスアドレス

BU6172GU のデバイスアドレスは“1001111”となります。



Fig.5 I²C デバイスアドレス

●I²Cバス AC特性

項目	記号	最小	最大	単位
CLK 周波数	fCLK	0	400	kHz
CLK 'L'区間	tLOW	1.3	-	μs
CLK 'H'区間	tHIGH	0.6	-	μs
バス開放時間	tBUF	1.3	-	μs
スタート条件 ホールド時間	tHD.STA	0.6	-	μs
スタート条件 セットアップ時間	tSU.STA	0.6	-	μs
DATA 入力ホールド時間	tHD.DAT	0	-	ns
DATA 入力セットアップ時間	tSU.DAT	100	-	ns
ストップ条件 セットアップ時間	tSU.STO	0.6	-	μs

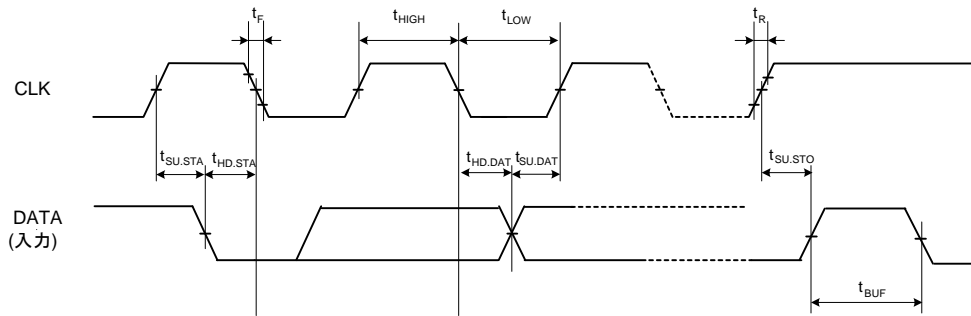


Fig.6 バスタイミング 1

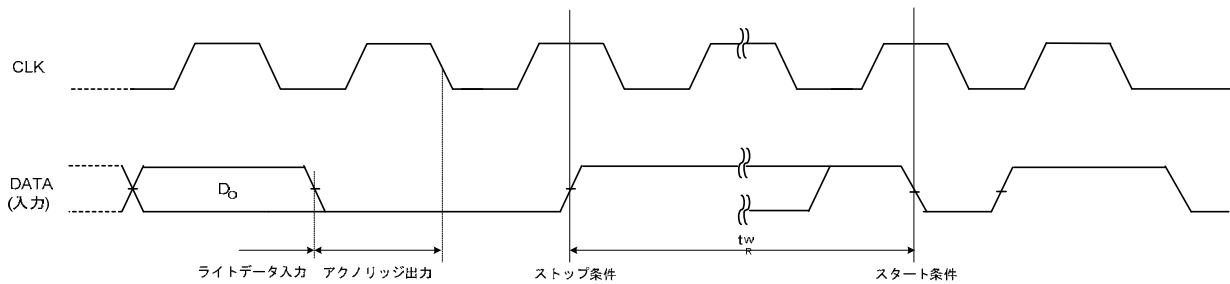


Fig.7 バスタイミング 2

●I²C レジスタ説明

OREGCNT(SWREGON、LDO*ON)

各 SWREG、LDO の ON/OFF を設定します。

0	ON
1	OFF

OSWADJ(SWREGADJ[3:0])

SWREG の出力電圧を 16STEP 変更することができます。

"0000"	0.80V
~	~
"1111"	2.40V

OLDLOADJ*(LDO*ADJ[3:0])

LDO1~5 の出力電圧を 16STEP 変更することができます。

"0000"	1.00V(LDO1、2)、1.20V(LDO3、4、5)
~	~
"1111"	3.30V

OPDSEL(SWPDSEL、LDO*PDSEL)

SWREG、LDO のディスチャージ抵抗値の変更をすることができます。

0	1kΩ
1	10kΩ

OPDCNT(SWPD、LDO*PD)

SWREG、LDO のディスチャージの有無を変更をすることができます。

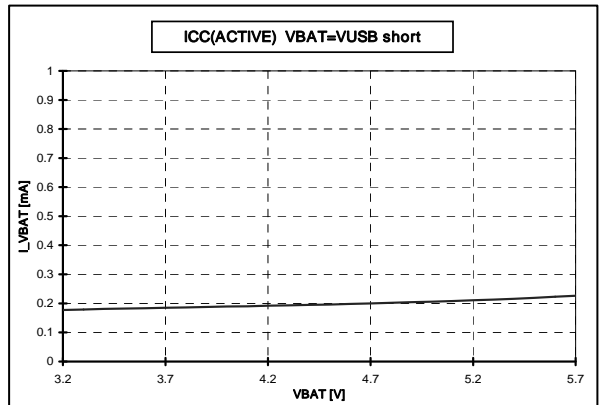
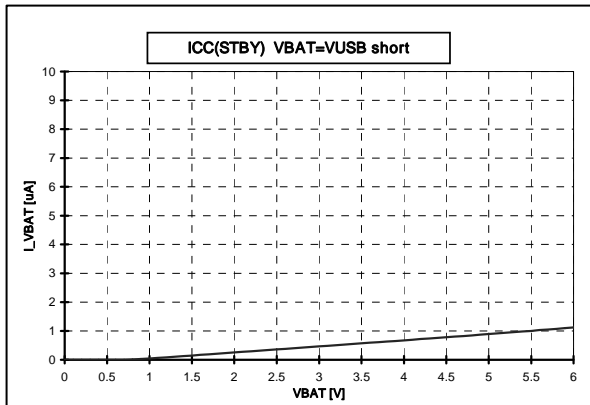
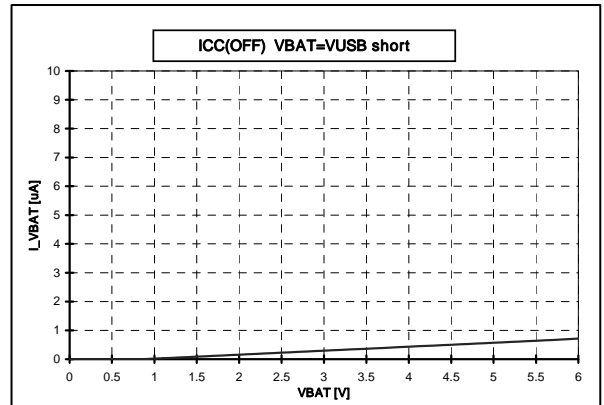
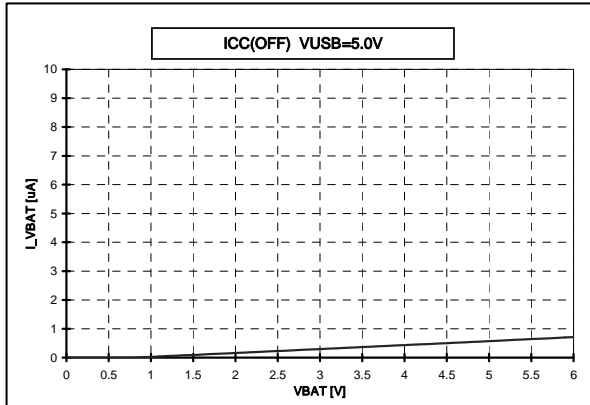
0	ディスチャージ無効
1	ディスチャージ有効

OEN_SEL(ENLD*_EN)

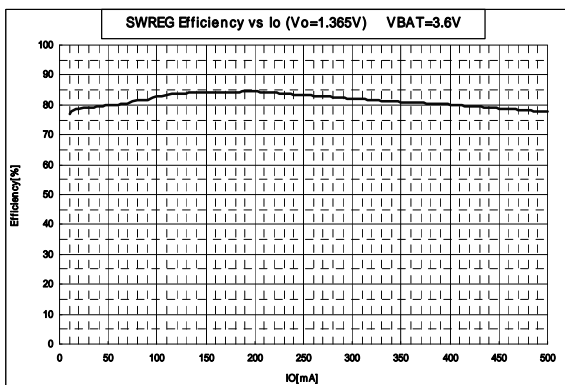
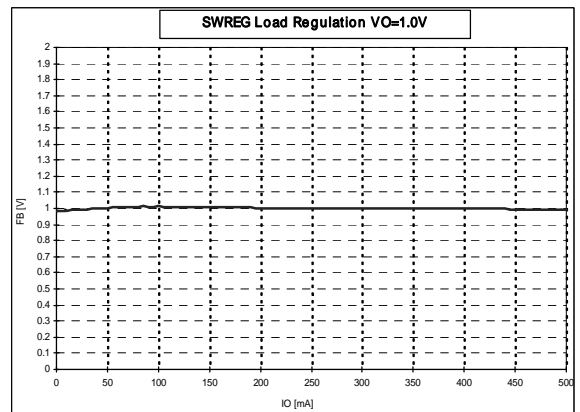
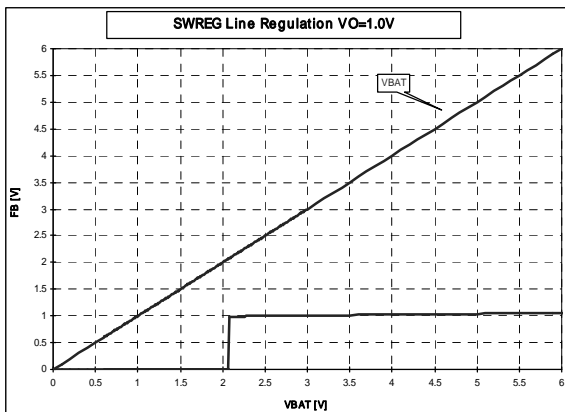
LDO1~4 について、外部イネーブル端子/I²C レジスタのいずれかの ON/OFF 制御を選択することができます。

0	外部イネーブル端子選択
1	I ² C レジスタ選択

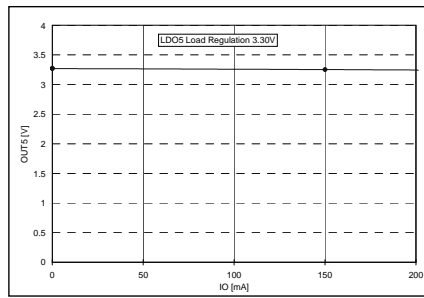
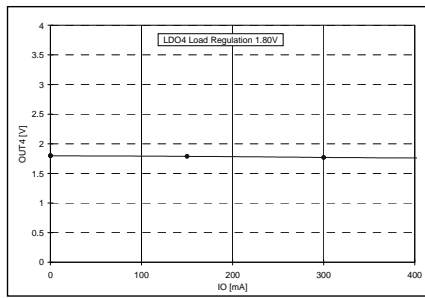
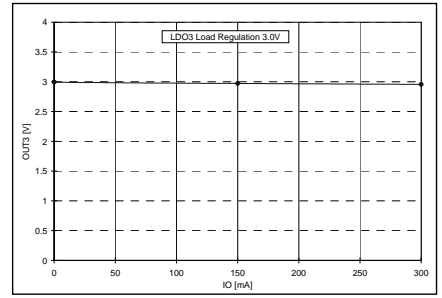
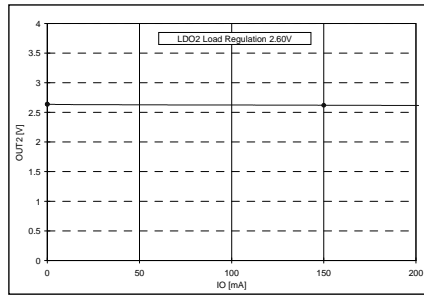
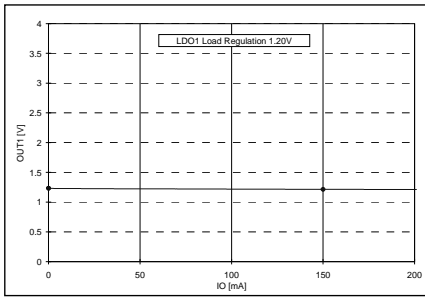
●参考データ(回路電流)



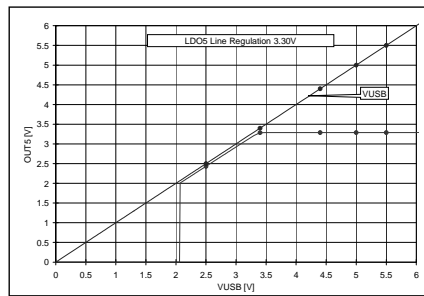
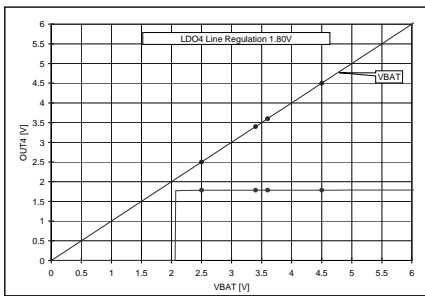
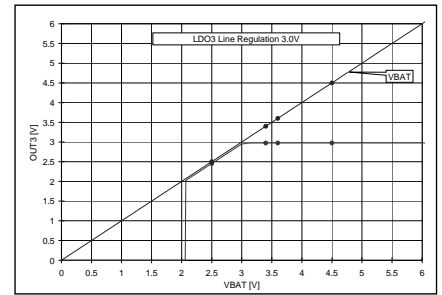
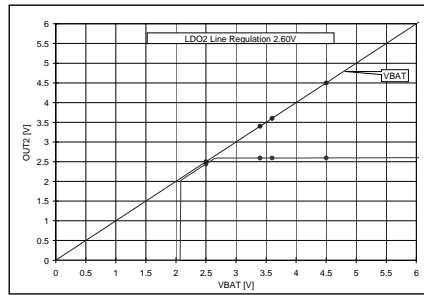
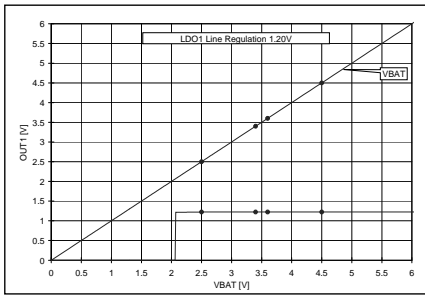
●参考データ(SWREG)



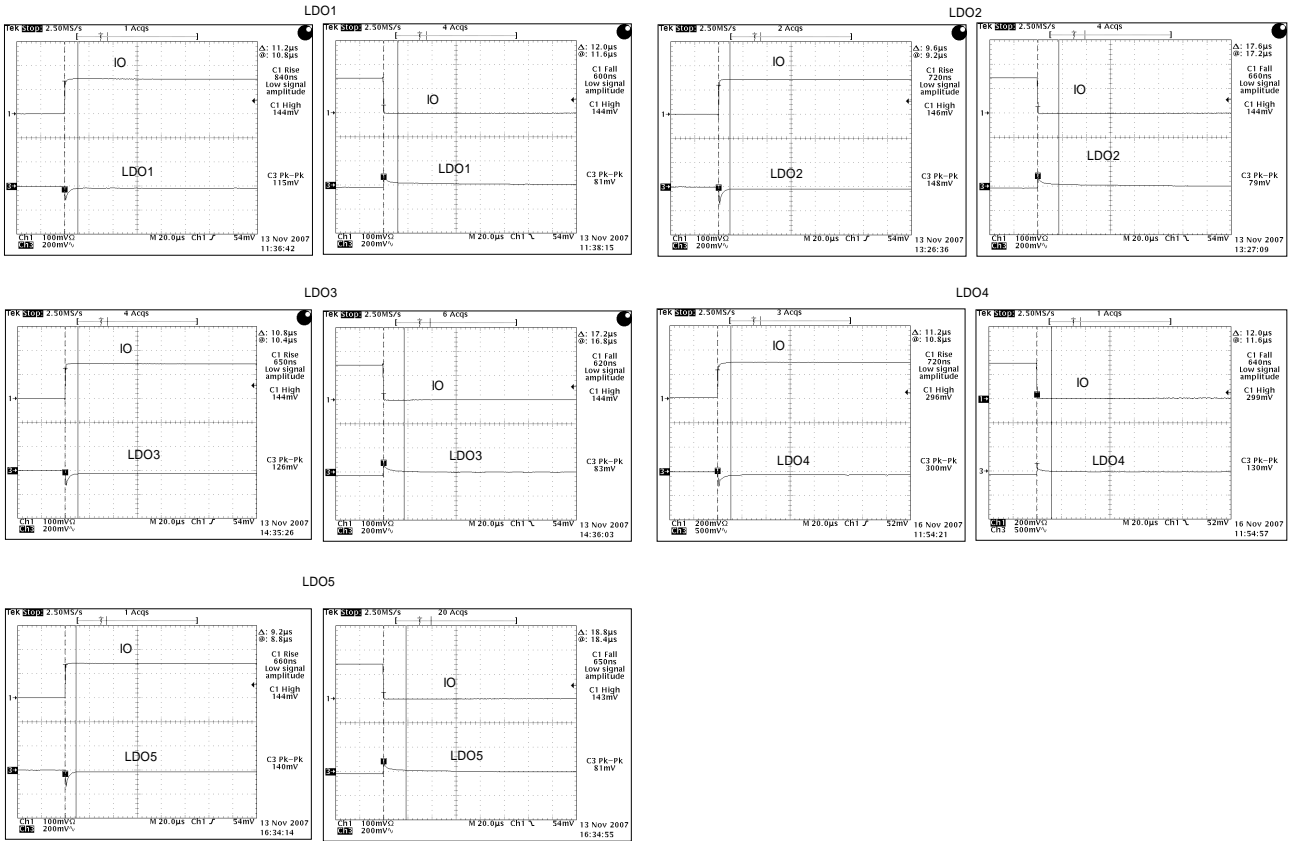
●参考データ(出力安定度)



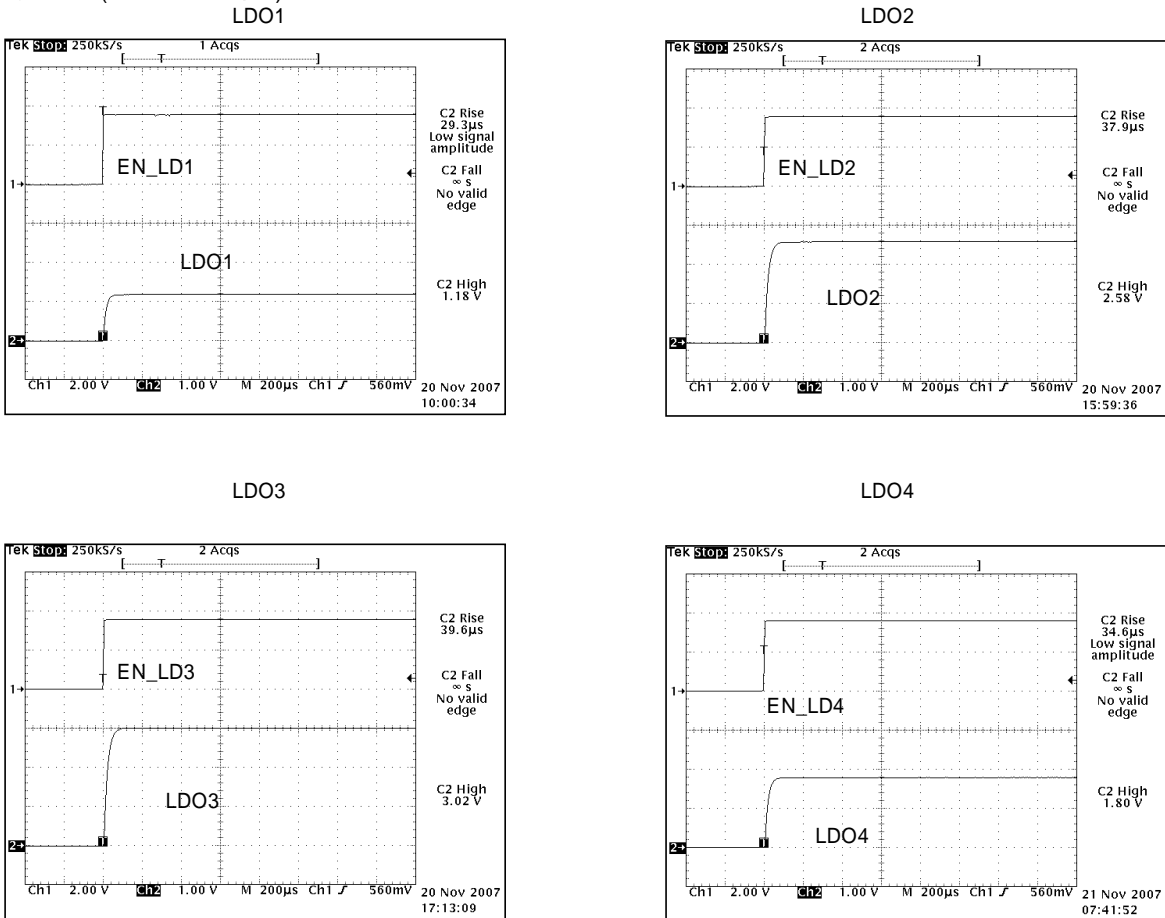
●参考データ(入力安定度)



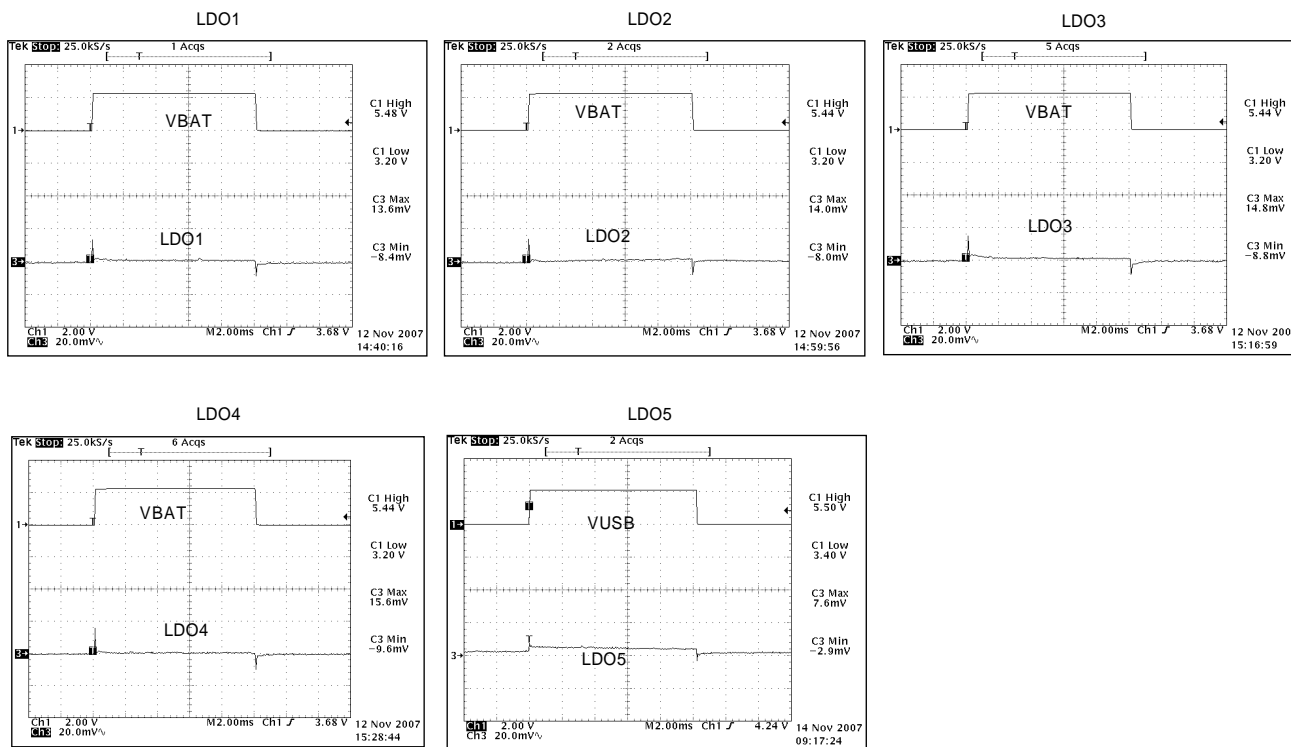
●参考データ(急峻負荷変動)



●参考データ(立ち上がり時間)



●参考データ(VBAT 電源急峻変動)



●使用上の注意点

- (1) 絶対最大定格について
印加電圧(VDD, VIN)、及び動作温度範囲(Topr)などの絶対最大定格を越えた場合、破壊する恐れがあり、ショートもしくはオープンなどの破壊モードが特定できませんので、絶対最大定格を越えるような特殊モードが想定される場合には、ヒューズなどの物理的な安全対策を施すよう検討をお願いします。
- (2) 推奨動作範囲
この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることができる範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。推奨動作範囲内であっても電圧、温度特性を示します。
- (3) 電源コネクタの逆接続について
電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。
- (4) 電源ラインについて
基板パターンの設計においては、電源/GND ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑止してください。GND ラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源-GND 端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬげが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。
- (5) GND 電圧について
GND 端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また、実際に過渡現象を含め GND 以下の電位になっている端子がないかご確認ください。
- (6) 端子間ショートと誤装着について
セット基板に取り付ける際、LSI の向きや位置ずれに十分ご注意ください。誤って取り付けた場合、LSI が破壊する恐れがあります。また、端子間や端子と電源、GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。
- (7) 強電磁界中の動作について
強電磁界中でのご使用は、誤動作をする可能性がありますのでご注意ください。
- (8) セット基板での検査について
セット基板での検査時に、インピーダンスの低い LSI 端子にコンデンサを接続する場合は、LSI にストレスがかかる恐れがあるので、工程毎に必ず放電を行ってください。また、検査工程での治具への着脱時には、必ず電源をオフしてから接続し、検査を行い、電源をオフしてから取り外してください。さらに、静電気対策として、組み立て工程には、アースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。
- (9) 各入力端子について
LSI の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的に形成されます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因となり得ます。したがって、入力端子に GND より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分注意してください。また、LSI に電源電圧を印加していない時、入力端子に電圧を印加しないでください。さらに、電源電圧を印加している場合にも、各入力端子は電源電圧以下の電圧もしくは電気的特性の保証値内としてください。
- (10) アース配線パターンについて
小信号 GND と大電流 GND がある場合、大電流 GND パターンと小信号 GND パターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号 GND の電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品の GND の配線パターンも変動しないように注意してください。
- (11) 外付けコンデンサについて
外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮の上定数を決定してください。
- (12) サーマルシャットダウン回路(TSD)について
ジャンクション温度が設定温度以上になるとサーマルシャットダウン回路が動作しスイッチの OFF を行います。サーマルシャットダウン回路はあくまでも熱的暴走から LSI を遮断することを目的とした回路であり、LSI の保護、及び保証を目的とはしておりません。よって、この回路を動作させての連続使用、及び動作を前提とした使用はしないでください。
- (13) 熱設計について
実際の使用状態での許容損失(Pd)を考えて十分なマージンを持った熱設計を行ってください。
- (14) ラッシュカレントについて
複数電源を持つ IC では電源投入順序、遅れにより、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、GND パターン配線の幅、引き回しに注意してください。

●発注形名セレクション

B	H
---	---

ローム形名

6	1	7	2
---	---	---	---

品番

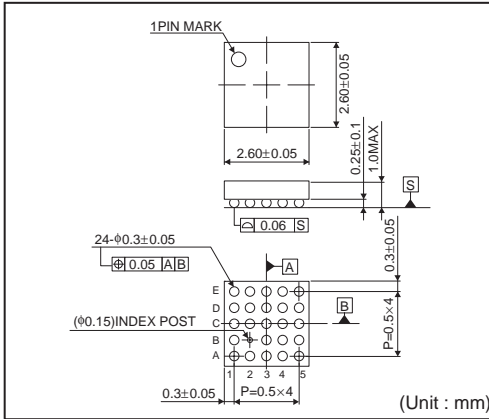
G	U
---	---

パッケージ
GU: VCSP85H2

E	2
---	---

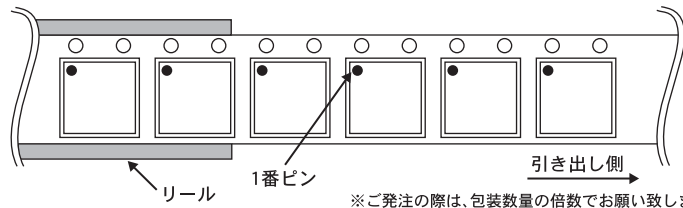
包装、フォーミング仕様
E2: リール状エンボステーピング

VCSP85H2(BH6172GU)



<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向



ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けはリフローはんだを原則とさせていただきます。なお、フロー方法でのご使用につきましては別途ロームまでお問い合わせください。詳細な実装及び基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルにQRコードが印字されていますが、QRコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を負いません。
2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。